



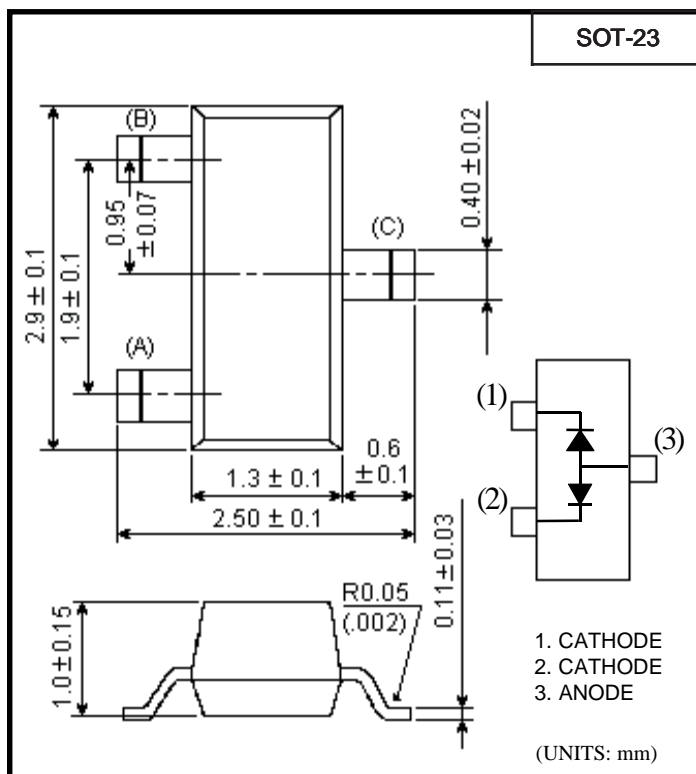
**SURFACE MOUNT, DUAL 1N4148 COMMON ANODE DIODE**

**Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)**

Items	Symbol	Ratings	Unit
Reverse Voltage	VRRM	85	V
Reverse Recovery Time	trr	4	ns
Forward Voltage @ If = 50 mA	VF	1.0	V
Forward Current	IF	215	mA
Junction Temp.	Tj	-55 to 150	°C
Storage Temp.	Tstg	-55 to 150	°C

**Mechanical Data**

Items	Materials
Package	SOT-23
Lead Frame	42 Alloy
Lead Finish	Solder Plating
Bond Wire	Au
Mold Resin	Epoxy
Chip	Silicon



**Electrical Characteristics per Diode (Ta=25°C)**

Ratings	Symbol	Ratings	Unit
Reverse Breakdown Voltage IR= 100uA	VBR	75	V
Repetitive Peak Reverse Voltage	VRRM	85	V
Repetitive Peak Forward Current	IFRM	450	mA
Forward Voltage	VF		mV
IF= 1mA		715	
IF= 10mA		855	
IF= 50mA		1000	
IF= 150mA		1250	
Reverse Current	IR		uA
VR= 75V		1.0	
VR= 25V (Tj= 150°C)		30	
VR= 75V (Tj= 150°C)		50	
Junction Capacitance VR = 0 V, f = 1MHz	Cj	2.0	pF
Reverse Recovery Time IF= IR= 10mA; RL= 100 ohms	trr	4	ns
Thermal Resistance (junction to ambient)	RθJA	500	°C/W

**MAXIMUM RATINGS** (at  $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	Max	UNITS
Continuous Forward Current	$I_F$	single diode loaded (note 1)	215	mA
		double diode loaded (note 1)	125	
Non-repetitive Peak Forward Current	$I_{FSM}$	square wave, $T_j = 25^\circ\text{C}$ prior to surge		
		$t = 1\mu\text{s}$	4	Amps
		$t = 1\text{ms}$	1	Amps
		$t = 1\text{s}$	0.5	Amps
Total Power Dissipation	$P_{TOT}$	$T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	250	mW

Note: 1. Device mounted on an FR4 printed-circuit board.

# RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( BAW56 )

FIG. 1 - Maximum permissible continuous forward current as a function of ambient temperature

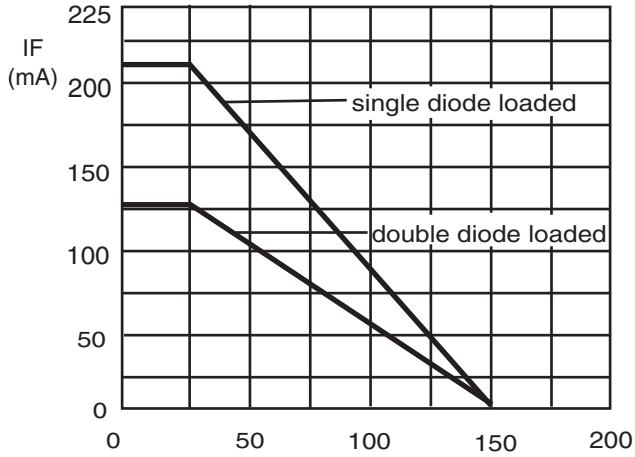


FIG. 2 - Forward current as a function of forward voltage

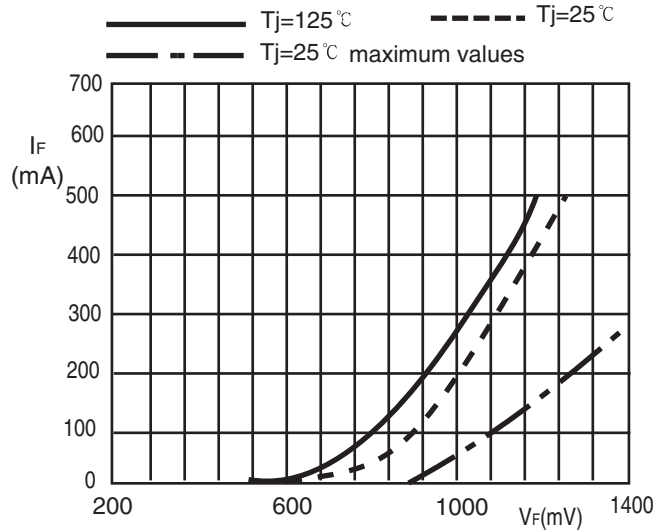


FIG. 3 - Maximum permissible non-repetitive peak forward current as a function of pulse duration

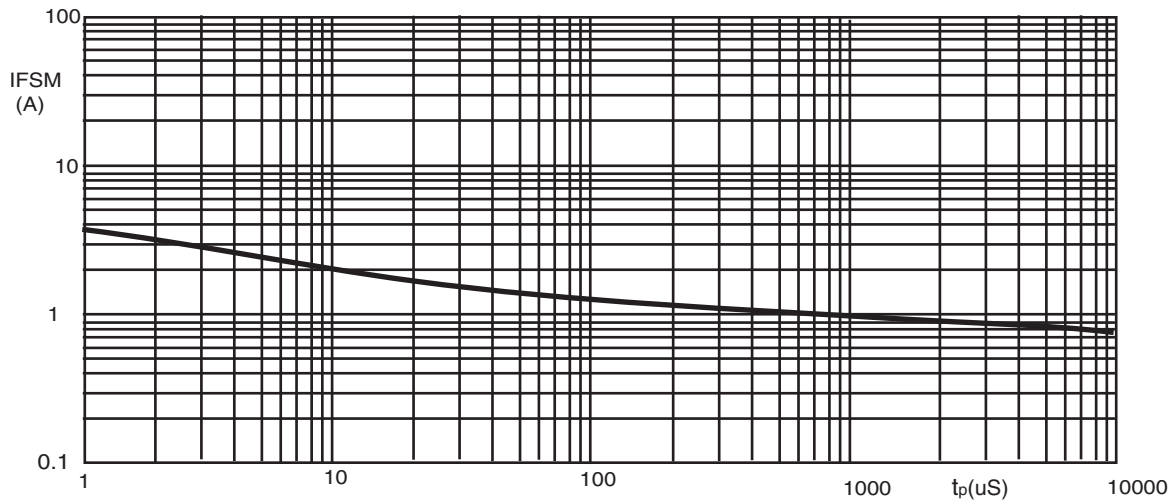


FIG. 4 - Reverse current as a function of junction temperature

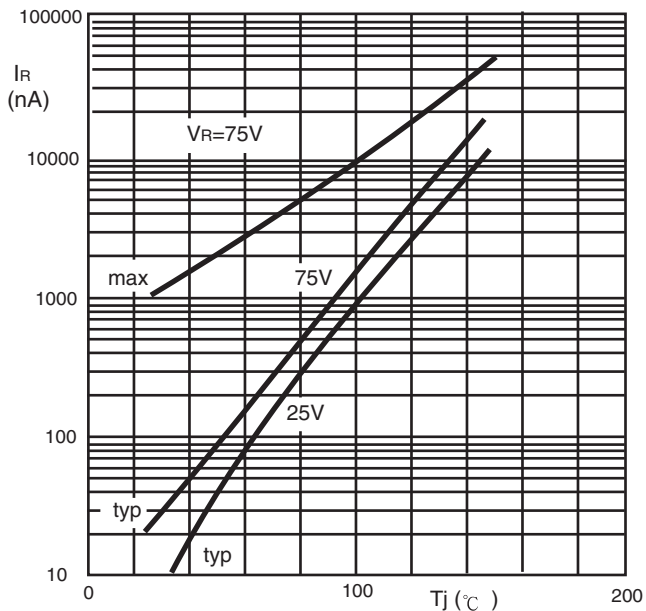
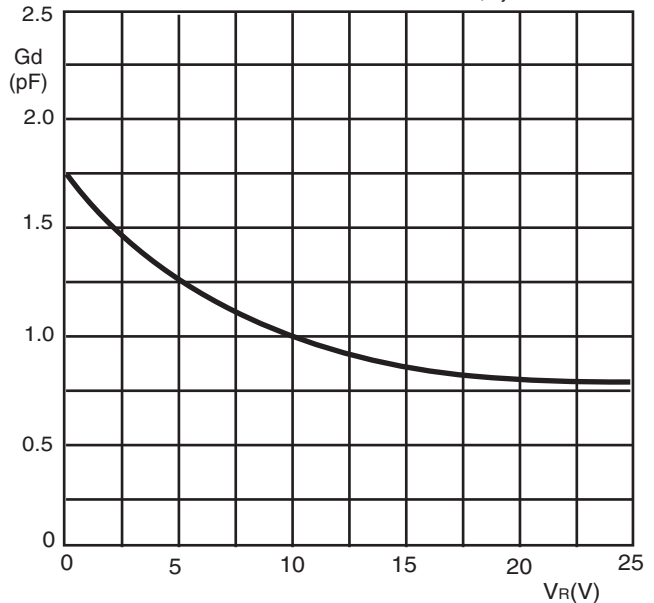


FIG. 5 - Diode capacitance as a function of reverse voltage ; typical values  $f=1\text{MHz}; T_j=25^\circ\text{C}$



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9